

Сведения о ведущей организации

Полное наименование и сокращенное наименование	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук; ИФП СО РАН
Место нахождения	Россия, г. Новосибирск
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты	Индекс: 630090; Адрес: пр. Ак. Лаврентьева, д. 13; Тел.: +7 383 330 90 55; Эл. почта: ifp@isp.nsc.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	http://www.isp.nsc.ru/
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<p>1. Rubanov S., Suvorova A., Popov V.P., Kalinin A.A., Pal'yanov Yu.N. Fabrication of graphitic layers in diamond using FIB implantation and high pressure high temperature annealing // Diam. Relat. Mater. – 2016. – V. 63. – P. 143-147.</p> <p>2. Zinovieva A.F., Smagina Zh.V., Nenashev A.V., Kulik L.V., Dvurechenskii A.V. Unusual narrowing of the ESR line width in ordered structures with linear chains of Ge/Si quantum dots // JETP Letters. – 2015. – V. 102. – P. 108-112.</p> <p>3. Popov V.P., Gutakovskii A.K., Antonov V.A., Podlesnyi S.N., Kupriyanov I.N., Palyanov Yu.N., Rubanov S.V. High-quality single-crystal diamond-graphite-diamond membranes and devices // Int. J. Nanotechnol. – 2015. – V. 12. – P. 226-237.</p> <p>4. Rebrov A., Emelyanov A., Kosolobov S., Yudin I. Diamond crystals deposited from interacting jets // Phys. Status Solidi C. – 2015. – V. 12. – P. 931-933.</p> <p>5. Popov V.P., Safronov L.N., Naumova O.V., Nikolaev D.V., Kupriyanov I.N., Palyanov Yu.N. Conductive layers in diamond formed by hydrogen ion implantation and annealing // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. – 2012. – V. 282. – P 100-107.</p> <p>6. Popok V., Samela J., Nordlund K., Popov V. Implantation of keV-energy argon clusters and radiation damage in diamond // Phys. Rev. B. – 2012. – V. 85. – P. 033405.</p> <p>7. Popov V.P., Safronov L.N., Naumova O.V., Nikolaev D.V., Palyvanov Yu.N., Kupriyanov I.N. Diamond – Graphite Heterostructures Formed by Nitrogen and Hydrogen Implantation and Annealing // Adv. Mater. – 2011. – V. 276. – P.27-33.</p>